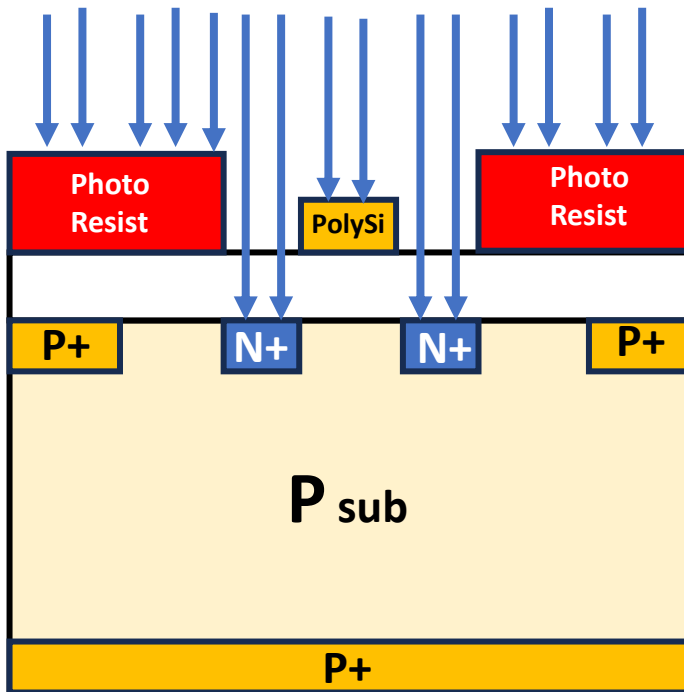


1971年当時、Intel 社は新しいイオン打ち込み装置を採用して
高性能な自己整合型MOSトランジスタの製造に成功し急成長しました。

Intel 1971 NMOS Transistor
with Self-Aligned S/D formation
by ion implantation method



Conventional N+P Single Junction Photodiode
with the serious image lag problem
in 1971 Interline Transfer CCD Image Sensors

